

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета

_____ Страхов С.Ю.

« ____ » _____ 20__

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ

Направление/специальность подготовки	12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии
Специализация/профиль/программа подготовки	Лазерная техника и лазерные технологии
Уровень высшего образования	Бакалавриат
Форма обучения	Очная
Факультет	И Информационные и управляющие системы
Выпускающая кафедра	И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА
Кафедра-разработчик рабочей программы	И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
4	7	3	108	51	34	17	0	57	0	0	57	диф. зач.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)**

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии

год набора группы: 2026

Программу составили:

Кафедра И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

Сергеев Андрей Александрович, старший преподаватель

Кафедра И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

Файда Янина Витальевна, ассистент

Программа рассмотрена

на заседании кафедры-разработчика

рабочей программы **И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА**

Заведующий кафедрой Борейшо А.С., д.т.н., проф.

Программа рассмотрена

на заседании выпускающей кафедры

И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА

Заведующий кафедрой Борейшо А.С., д.т.н., проф.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ

Разделы рабочей программы

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Приложения к рабочей программе дисциплины

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-1.1 — Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем

ПК-1.3 — Способен к расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

ПК-1.1

знания:

физических основ действия полупроводниковых лазеров;

устройства и основных характеристик полупроводниковых излучателей;;

умения:

анализировать задачи по проектированию типовых приборов, узлов и деталей полупроводниковой лазерной техники;;

навыки:

расчета и регулировки мощности излучения полупроводникового лазера;.

ПК-1.3

знания:

способов достижения высоких спектральных характеристик полупроводниковых лазеров;

методов стабилизации мощности и длины волны излучения полупроводниковых лазеров;

методик расчета характеристик излучения полупроводниковых лазеров;;

умения:

рассчитывать и проводить измерения мощности излучения полупроводниковых лазеров;

проводить измерения длины волны излучения;;

навыки:

работы с измерительным оборудованием для оценки спектра и шумов полупроводниковых лазеров;.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА, ФИЗИКА, ОСНОВЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕХНИКИ**.

Содержание дисциплины является основой для освоения дисциплин: **ЛАЗЕРНЫЕ СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ОПК-1 — Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования в инженерной деятельности, связанной с проектированием, конструированием и технологиями производства лазерной техники
- ОПК-3 — Способен проводить экспериментальные исследования и измерения, обрабатывать и представлять полученные данные с учетом специфики методов и средств лазерных исследований и измерений
- ПК-1.1 — Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем
- ПК-1.3 — Способен к расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях
- ПК-1.5 — Способен проводить численные оценки параметров лазерного излучения и процессов взаимодействия лазерного излучения со средами

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %	
				ВСЕГО	Лекции	Лабораторный практикум		ПК-1.1	ПК-1.3
4	7	Раздел 1. Основы оптики полупроводников и элементы квантовой статистики. 1.1. Зонная модель твердого тела, зоны Бриллюэна. Уравнение Шредингера, волновая функция электронов в кристалле. 1.2. Электронно-дырочные пары, процессы излучения и поглощения света в твердом теле. 1.3. Распределение Ферми-Дирака. Плотность состояний электронов и дырок. 1.4. Уровни Ферми. Квазиуровни Ферми. Условие усиления света в полупроводниках.	18	8	8	0	10	10	50
4	7	Раздел 2. Усиление света в р-п переходе и в гетероструктурах. 2.1. Структура р-п перехода. Границы энергетических зон в электрическом поле. 2.2. Излучательная, безызлучательная и Оже- рекомбинация электронно-дырочных пар. 2.3. Полупроводниковые гетероструктуры. Усиление света в гетероструктурах. Ширина запрещенной зоны и условие изопериодичности. 2.4. Волноводные свойства р-п перехода.	20	10	10	0	10	10	30
4	7	Раздел 3. Оптические резонаторы и волноводные решетки Брэгга. 3.1. Волноводный интерферометр Фабри-Перо. 3.2. Постоянная распространения излучения в волноводе с оптическим усилением. Модовый коэффициент ограничения. 3.3. Квантоворазмерные структуры, их свойства и особенности. 3.4. Волноводные решетки Брэгга. РОС, РБО и РБЗ-лазеры.	18	8	8	0	10	30	10
4	7	Раздел 4. Характеристики излучения полупроводниковых лазеров. 4.1. Ватт-амперные характеристики полупроводниковых лазеров. 4.2. Временные и спектральные характеристики ПЛ. 4.3. Способы создания одночастотного режима генерации ПЛ. 4.4. Угловые и поляризационные характеристики ПЛ.	52	25	8	17	27	50	10
Всего за 7 семестр			108	51	34	17	57	100	100
Всего по дисциплине			108	51	34	17	57	100	100

3.2. Лабораторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема лабораторного практикума	Объем, ауд. часов
1	Раздел 4. Характеристики излучения полупроводниковых лазеров.	Исследование температурной перестройки длины лазерного диода	4
2		Исследование токовой перестройки длины лазерного диода	4
3		Измерение Ватт-Амперной характеристики полупроводникового диода	9
Всего за 7 семестр			17

3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем часов
1	Раздел 1. Основы оптики полупроводников и элементы квантовой статистики.	Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	10
2	Раздел 2. Усиление света в р-п переходе и в гетероструктурах.	Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	10
3	Раздел 3. Оптические резонаторы и волноводные решетки Брэгга.	Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	10
4	Раздел 4. Характеристики излучения полупроводниковых лазеров.	Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы «Исследование токовой перестройки длины лазерного диода»	6
5		Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	10
6		Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы «Измерение Ватт-Амперной характеристики полупроводникового диода»	5
7		Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы «Исследование температурной перестройки длины лазерного диода»	6
Всего за 7 семестр			57

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

СЕМЕСТР	НЕДЕЛИ СЕМЕСТРА																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7						ДР		Отч. по ЛР	ЛР	ДР	Отч. по ЛР	ЛР		Отч. по ЛР	ЛР	ДР	Колл, диф. зач.

Условные обозначения:

- ДР – диагностическая работа;
- Отч. по ЛР – отчет по ЛР;
- ЛР – лабораторная работа;
- Колл – коллоквиум;
- диф. зач. – дифференцированный зачет.

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- отчет по ЛР;
- лабораторная работа;
- коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. А. Е. Жуков. . Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур. СПб.: Элмор, 2007, эл. рес.
2. В. П. Грибковский. . Полупроводниковые лазеры. Минск: Университетское, 1988, эл. рес.
3. Г. Л. Киселёв. . Квантовая и оптическая электроника. Санкт-Петербург: Лань, 2022, эл. рес.
4. И. С. Тарасов. . Полупроводниковые лазеры. СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2011, эл. рес.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

не требуются.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <https://www.ura-it.ru/> — Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов.;
2. <http://e.lanbook.com/> — ЭБС Лань;
3. <http://library.voenmeh.ru/jirbis2/> — Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;
3. <http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457 - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/>- КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

не требуется.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционные занятия:

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

6.2. Лабораторные занятия:

1. Установка для исследования полупроводниковых лазеров.

6.3. Прочее:

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

Аннотация рабочей программы

Дисциплина **ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ** является дисциплиной **части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1**, программы подготовки по направлению *12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии*. Дисциплина реализуется на факультете *И Информационные и управляющие системы* БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова кафедрой *И1 ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА*.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ПК-1.1 Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем;

ПК-1.3 Способен к расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с принципами работы и характеристиками полупроводниковых лазеров.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

Текущий контроль успеваемости студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- отчет по ЛР;
- лабораторная работа;
- коллоквиум.

Промежуточная аттестация проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е., **108 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**34 ч.**), лабораторный практикум (**17 ч.**), самостоятельная работа студента (**57 ч.**).

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 108 ч., из них 51 ч. аудиторных занятий, и 57 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Основы оптики полупроводников и элементы квантовой статистики.		
Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	Г. Л. Киселёв. . Квантовая и оптическая электроника: Санкт-Петербург: Лань, 2022 (1, 8) А. Е. Жуков. . Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур: СПб.: Элмор, 2007 (часть 1) И. С. Тарасов. . Полупроводниковые лазеры: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2011 (лекции 1, 3, 8)	10
Итого по разделу 1		10
Раздел 2. Усиление света в р-п переходе и в гетероструктурах.		
Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	В. П. Грибковский. . Полупроводниковые лазеры: Минск: Университетское, 1988 (лекции 2, 3, 7) А. Е. Жуков. . Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур: СПб.: Элмор, 2007 (части 3 и 4)	10
Итого по разделу 2		10
Раздел 3. Оптические резонаторы и волноводные решетки Брэгга.		
Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе	Г. Л. Киселёв. . Квантовая и оптическая электроника: Санкт-Петербург: Лань, 2022 (3) А. Е. Жуков. . Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур: СПб.: Элмор, 2007 (части 3, 5) И. С. Тарасов. . Полупроводниковые лазеры: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2011 (6, 8, 13)	10
Итого по разделу 3		10
Раздел 4. Характеристики излучения полупроводниковых лазеров.		
Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы «Исследование токовой перестройки длины лазерного диода»	И. С. Тарасов. . Полупроводниковые лазеры: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2011 (лекции 10,13) А. Е. Жуков. . Лазеры на основе полупроводниковых наноструктур: СПб.: Элмор, 2007 (часть 8)	6
Изучение предусмотренных программой дидактических единиц по материалам лекционных занятий и рекомендуемой литературе		10
Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы «Измерение Ватт-Амперной характеристики полупроводникового диода»		5
Подготовка к выполнению и защите лабораторной работы «Исследование температурной перестройки длины лазерного диода»		6
Итого по разделу 4		27

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- коллоквиум;
- лабораторная работа;
- отчет по ЛР;
- дифференцированный зачет.

Критерии оценивания

Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

Коллоквиум

Коллоквиум проводится по разделам дисциплины в устной форме и включает в себя ответ на 2 теоретических вопроса.

Тематики коллоквиума представлены в УМК дисциплины.

Лабораторная работа

Защита ЛР предусматривает обсуждение результатов выполнения задания, включая проверку усвоения студентом соответствующих сведений из теории.

Отчет по ЛР

Отчеты по лабораторным работам представляются в печатной или рукописной форме. Допускается выполнение расчетов «вручную» или использование систем автоматизации математических расчетов. Каждое задание на лабораторную работу содержит набор параметров в соответствии с индивидуальным вариантом.

Критерии оценивания:

Лабораторная работа считается выполненной успешно (принимается) при следующих условиях:

- правильное выполнение всех пунктов (задач), предусмотренных заданием;
- правильное построение и оформление в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД графиков, для всех получаемых в ходе выполнения задания характеристик, и отчёта в целом;
- предоставление отчёта в срок, указанный преподавателем.

Дифференцированный зачет

Итоговый контроль по дисциплине проходит в форме дифференцированного зачета. К зачету допускаются студенты которые успешно выполнили все лабораторные работы и сдали отчеты.

Зачет проводится в устной форме и включает в себя ответ на 2 теоретических вопроса.

Оценка «зачтено-отлично» ставится, если ответ на оба вопроса является полным и правильным. Материал изложен в определенной логической последовательности. При ответе на дополнительные вопросы студент показал знание основного содержания курса.

Оценка «зачтено - хорошо» ставится, если ответ на оба вопроса является полным и правильным, при этом допущены несущественные ошибки, исправленные после наводящих вопросов преподавателя. При ответе на дополнительные вопросы студент демонстрирует понимание основного содержания учебного материала. Студент свободно ориентируется в материале, изложенном в конспекте.

Оценка «зачтено - удовлетворительно» выставляется, если студент обнаруживает знание и понимание материала курса, но излагает материал неполно и допускает существенные ошибки в формулировке основных понятий и законов. Ответ на дополнительные вопросы вызывает у учащегося затруднения или содержит ошибки, которые он может исправить после наводящих вопросов.

Оценка «не зачтено» выставляется, если при ответе обнаружено непонимание основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах преподавателя.

При выставлении оценки учитывается качество выполнения лабораторных работ, уровень и своевременность защиты лабораторных работ, а также посещаемость лекционных занятий и личное участие в обсуждении материала.

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %		НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Лабораторный практикум		ПК-1.1	ПК-1.3	
4	7	Раздел 1. Основы оптики полупроводников и элементы квантовой статистики.	18	8	8	0	10	10	50	Коллоквиум
4	7	Раздел 2. Усиление света в р-п переходе и в гетероструктурах.	20	10	10	0	10	10	30	Коллоквиум
4	7	Раздел 3. Оптические резонаторы и волноводные решетки Брэгга.	18	8	8	0	10	30	10	Коллоквиум
4	7	Раздел 4. Характеристики излучения полупроводниковых лазеров.	52	25	8	17	27	50	10	Лабораторная работа, Отчет по ЛР, Коллоквиум
Всего за 7 семестр			108	51	34	17	57	100	100	
Всего по дисциплине			108	51	34	17	57	100	100	

Оценочные материалы по дисциплине ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ЛАЗЕРЫ

ПК-1.1 - Способен к анализу задачи по проектированию типовых систем, приборов, узлов и деталей лазерной техники, лазерных оптико-электронных приборов и систем

- № 1 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
Выберите отличительные особенности полупроводниковых лазеров

Варианты ответа

1. Высокая квантовая эффективность
2. Возможность получения узкого спектра излучения
3. Возможность получения широкого спектра излучения
4. Малые размеры
5. Возможность высокочастотной модуляции излучения без использования внешних модуляторов
6. Разнообразие способов создания инверсной населенности
7. Возможность регулировать мощность излучения в очень широких пределах

- № 2 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
Перечислить известные конструкции оптических резонаторов, используемые в полупроводниковых лазерах, с указанием способа вывода излучения

- № 3 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
Описать рекомбинационные процессы в полупроводниковом лазере в зависимости от уровня накачки

- № 4 Прочитайте текст и установите соответствие
Поставьте в соответствие

1. Гомопереход –
2. Гетеропереход –

Варианты ответа

- А. это контакт двух областей однородного ПП с разными типами проводимости или концентрациями легирующей примеси
- Б. это контакт двух различных по хим.составу ПП, при котором кристаллическая решётка одного материала без нарушения периодичности переходит в решётку другого материала
- В. это переход, при котором электроны приобретают протоны
- Г. это переход между полупроводником и изолятором

- № 5 Прочитайте текст и установите соответствие

Продолжите фразы:

1. При стимулированном излучении рождается фотон
 2. При спонтанном излучения рождается фотон
- А) с удвоенной частотой по отношению к прилетающему фотону
- Б) меньшей энергией по отношению к прилетающему фотону
- В) с такой же длиной волны, как и прилетевший фотон
- Г) со случайчайной фазой
- Д) со случайной энергией

- № 6 Прочитайте текст и установите последовательность

Расставьте в порядке возрастания мощности перечисленные приборы.

1. Одномодовый полупроводниковый лазер без усилителя
2. Красный многомодовый лазер в корпусе ТО 9 мм
3. Матрица лазерных диодов
4. Синий многомодовый лазер в корпусе ТО 9 мм

- № 7 Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите слои полупроводникового лазера по порядку от p-контакта к p.

1. р - контакт
2. п - контакт
3. Эмиттерный слой р-типа
4. Волноводный слой р-типа
5. Активная среда
6. Волноводный слой п-типа
7. Эмиттерный слой п-типа

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Что происходит в активной среде полупроводникового лазера при токе накачки меньше порогового?

Варианты ответа

1. Кристалл не излучает, вся энергия переходит в тепло
2. Кристалл излучает когерентно, но очень слабо
3. Кристалл излучает некогерентное люминесцентное излучение
4. Активно генерируются фононы

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Какова величина спина электронов и дырок в полупроводниковом кристалле?

Варианты ответа

1. Полу-целое число \hbar
2. Целое число \hbar
3. Спин не зависит от \hbar
4. Спин не имеет определенного значения

№ 10 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
В чем причина образования энергетической "запрещенной зоны" в полупроводниковом кристалле?

Варианты ответа

1. Волновые свойства электрона
2. Конечная величина ионизационного потенциала атомов
3. Температурная зависимость энергии микрочастиц
4. Различие эффективных масс электронов и дырок

№ 11 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
Какие спектральные полосы энергетических состояний с точки зрения поглощения и усиления света в полупроводнике будут в состоянии равновесия? (Выберите все верные ответы)

- А) полоса пропускания
- Б) полоса поглощения
- В) полоса усиления

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
От чего зависит поглощение света в полупроводнике? (Выберите все верные ответы)

- А) от наличия свободных состояний в зоне проводимости, соответствующих энергии фотона
- Б) от наличия электронов в валентной зоне
- В) от уровня легирования
- Г) от ширины запрещенной зоны

ПК-1.3 - Способен к расчету, проектированию и конструированию в соответствии с техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и элементном уровнях

№ 1 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Каким способом можно добиться инжекции электронов из валентной зоны в зону проводимости

Варианты ответа

1. При проектировании изделия, предусмотреть подключение лазера таким образом, чтобы ток протекал через р-п переход в прямом направлении

2. При проектировании изделия, предусмотреть подключение лазера таким образом, чтобы ток протекал через р-п переход в обратном направлении
3. В полупроводниковом лазере не возникает инжекции электронов

№ 2 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Когда происходит генерация света в полупроводниковых структурах?

Варианты ответа

1. при переходе электронов из запрещенной зоны в зону проводимости
2. при переходе электронов из валентной зоны в зону проводимости
3. при переходе электронов из зоны проводимости в валентную зону
4. при переходе электронов из запрещенной зоны в валентную зону

№ 3 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа
Какой вид модуляции в полупроводниковых источниках света осуществляется посредством изменения тока накачки?

Варианты ответа

1. Модуляция мощности (амплитуды)
2. Модуляция интенсивности
3. Модуляция поляризации
4. Модуляция температуры

№ 4 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
Каким образом можно изменить центральную длину волны, излучаемую полупроводниковым лазером?

Варианты ответа

1. Изменить ток накачки (инжекции)
2. Изменить тип выходного волокна
3. Установить оптический фильтр на выходе
4. Изменить температуру кристалла

№ 5 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

От чего зависит эффективность излучательной рекомбинации? (Выберите все верные ответы)

установите
соответствие

- А) от концентрации носителей заряда
- Б) от кристаллического совершенства кристалла
- В) от кристаллографической ориентации кристалла

№ 6 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов
Какие виды легирования полупроводников существуют?

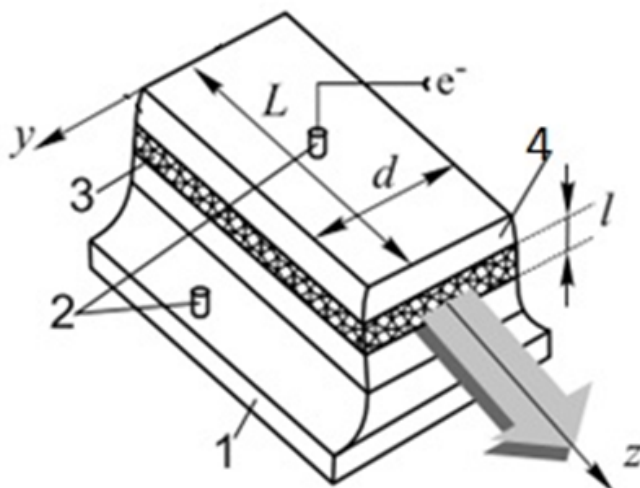
(Выберите все верные ответы)

- А) донорное
- Б) акцепторное
- В) компенсированное
- Г) вынужденное

№ 7 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
Чем отличается полупроводниковый лазер от других типов лазеров, и какие основные принципы работы лежат в его основе?

№ 8 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ
Какой процесс используется для формирования оптического резонатора в полупроводниковом лазере, и какие параметры необходимо учитывать при расчете и проектировании такого резонатора?

№ 9 Прочитайте текст и установите соответствие
На рисунке представлена структурная схема инжекционного лазера.



Цифрой (1) обозначено -
 Цифрой (2) обозначено -
 Цифрой (3) обозначено -
 Цифрой (4) обозначено -

Варианты ответа

- А. Подложка
- Б. Электрические контакты инжекции носителей
- В. р-п переход
- Г. Полированная грань

№ 10 Прочитайте текст и установите соответствие

Вставьте пропущенные слова

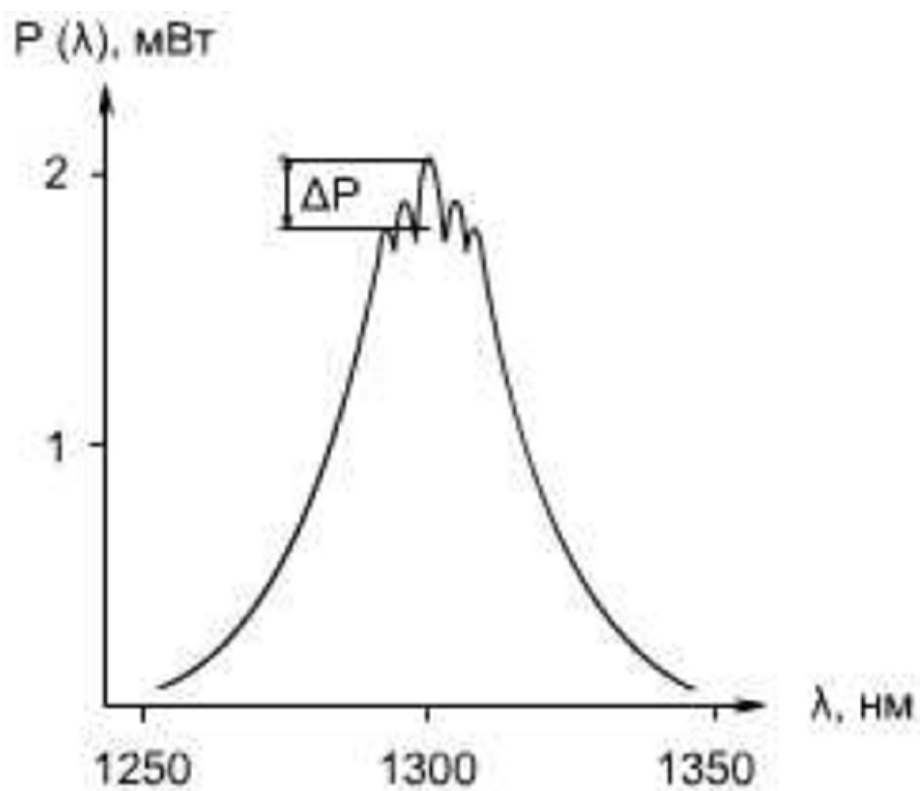
Увеличение количества [[1]] соответствует [[2]] энергии, а процесс [[3]] ведёт к [[4]] энергии

Варианты ответа

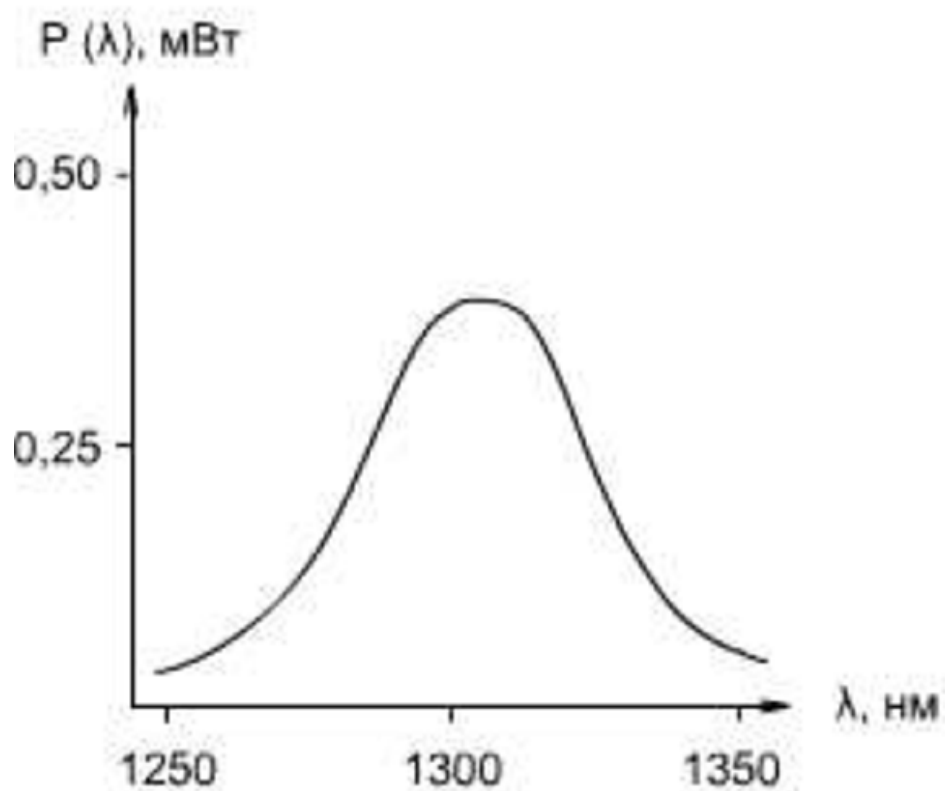
- А. ЭДП
- Б. электронов
- В. дырок
- Г. поглощению
- Д. выделению
- Е. рекомбинации
- Ж. распада

№ 11 Прочитайте текст и установите последовательность

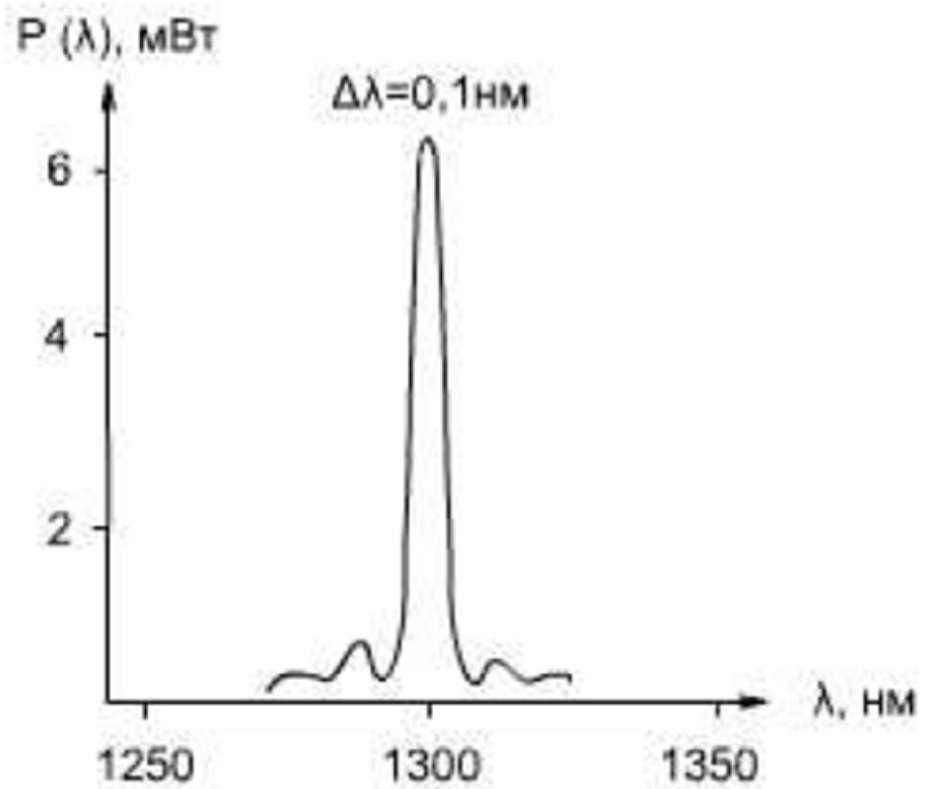
Расположите спектры излучения в следующем порядке: лазерный диод, светоизлучающий диод, суперлюминесцентный диод.



2



3



№ 12 Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите одноэлементные полупроводниковые лазеры по увеличению максимально достижимой мощности:

1. Зеленый лазер
2. Синий лазер
3. Красный лазер